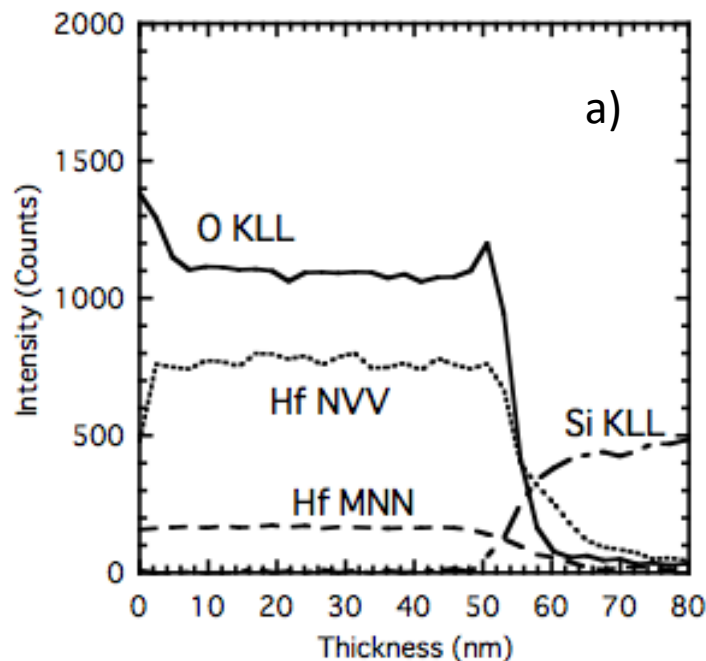


研究論文, ” 極低角度入射ビームオージェ深さ方向分析によるHfO₂/Si基板の分析” に掲載されている Fig. 12
オージェデプスプロファイルの Raw data ファイル

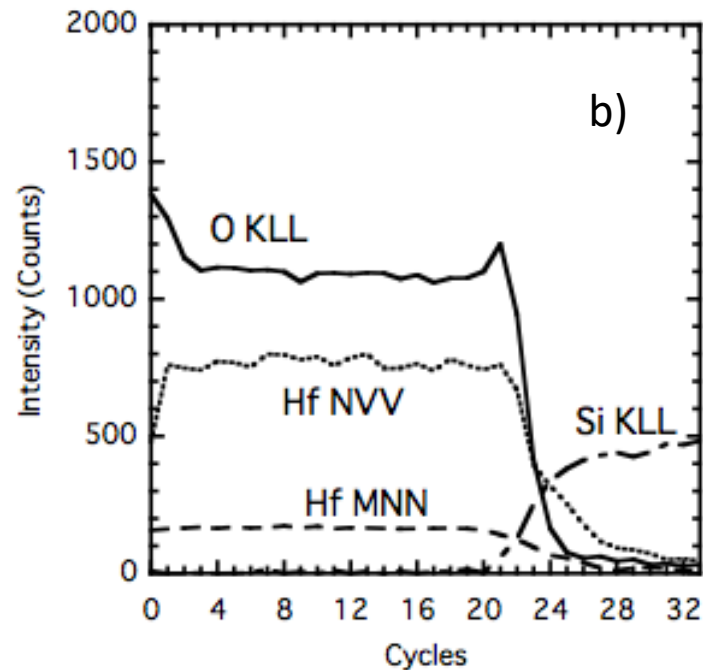
DOI

<https://doi.org/10.1384/jsa.24.192>

荻原俊弥, 長田貴弘, 吉川英樹, *J. Surf. Anal.* **24**, 192 (2018).



AES depth profiles of the HfO₂:55 nm/Si substrate
using the conventional method with the argon ion
energy of 3.0 keV.



AES depth profiles of the HfO₂:55 nm/Si substrate
using the conventional method with the argon ion
energy of 3.0 keV.

a) のオージェデプスプロファイルは論文に掲載の Fig. 12 に相当し, 横軸は nm である.
b) は横軸を測定回数で表したものであり, 横軸を nm に変換する前のプロファイルである.
Raw data ファイルは, b) に対応している.